

V _{OUT} (V)	L (μH)	C2 (μF)	R3 (kΩ)	C3 (pF)	C6
1.8	4.7	47	105	100	None
2.5	4.7 - 6.8	22	54.9	220	None
3.3	6.8 -10	22	68.1	220	None
5	15 - 22	22	100	150	None
12	22 - 33	22	147	150	None



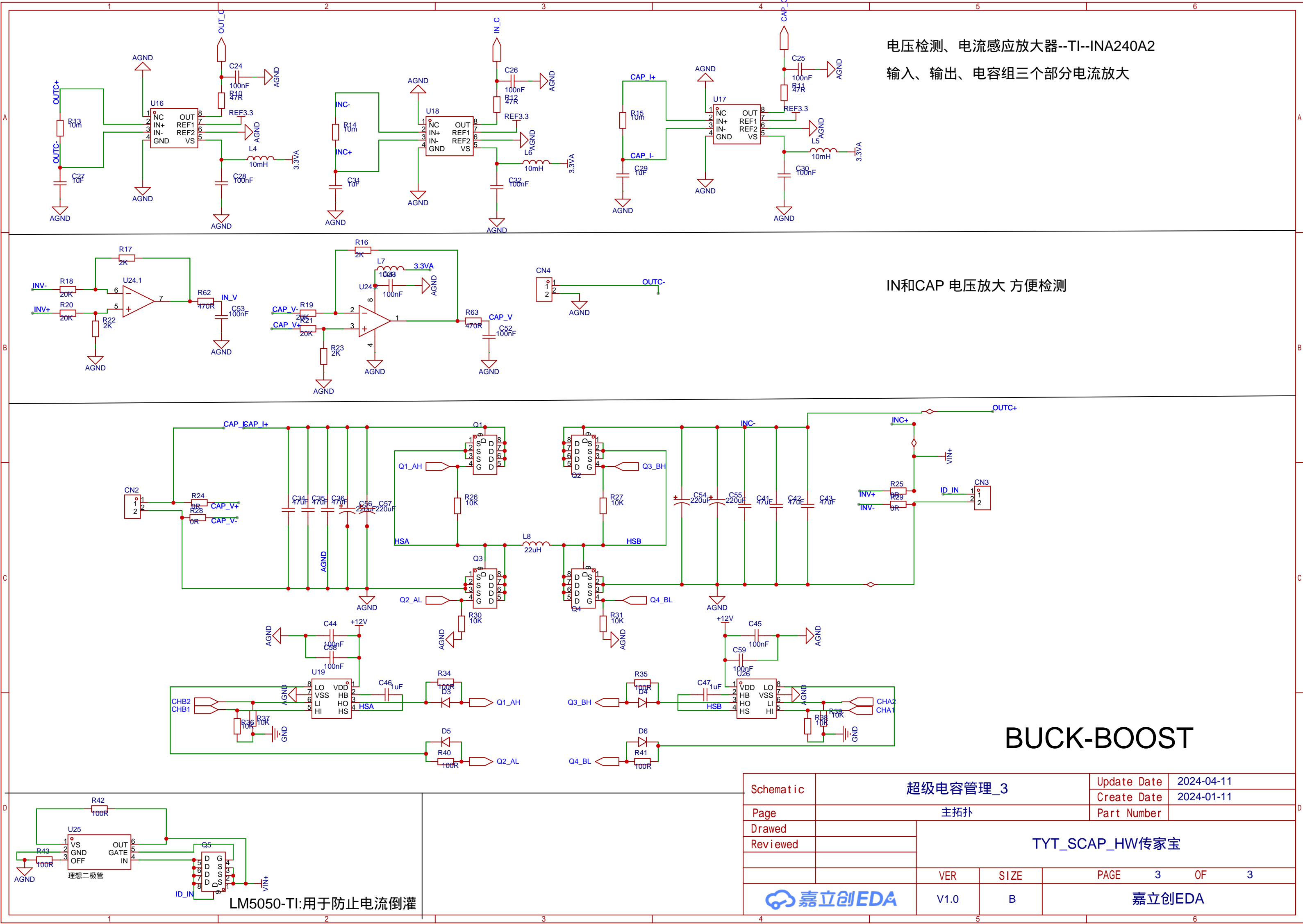
3 Description

The LM5050-1/-Q1 High Side OR-ing FET Controller operates in conjunction with an external MOSFET as an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. This ORing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops.

The LM5050-1/-Q1 controller provides charge pump gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response comparator to turn off the FET when current flows in the reverse direction. The LM5050-1/-Q1 can connect power supplies ranging from 5 V to 75 V and can withstand transients up to 100 V.

INA240-Q1 器件是一款经汽车认证的电压输出、电流检测放大器，具有增强型 PWM 抑制功能，可在独立于电源电压的 - 4V 至 80V 宽共模电压范围内检测分流器电阻上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压，从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可为使用脉宽调制 (PWM) 信号的系 统（例如，电机驱动和螺线管控制系统）中的较大共模瞬变 ($\Delta V/\Delta t$) 提供高水平的抑制。凭借该功能，可精确测量电流，而不会使输出电压产生较大的瞬变及相应的恢复纹波。

该器件由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电运行，消耗的最大电源电流为 2.4mA。共有四种固定增益可供选择：20V/V、50V/V、100V/V 以及 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV（满量程）的情况下进行电流感应。1 级版本具有额定的扩展工作温度范围（- 40°C 至 +125°C），并且采用 8 引脚 TSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。0 级版本具有额定的扩展工作温度范围（- 40°C 至 +150°C），并且采用 8 引脚 SOIC 封装。



必须注意避免将VDD迹线放置在LO、HS和HO信号附近
对LO和HO使用宽走线，紧密跟随相关的GND或HS走线。在可能的情况下，宽度为60至100密耳是可取的。